

SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

FZT758

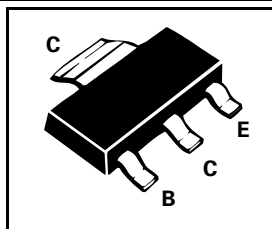
ISSUE 2 – FEBRUARY 1995

FEATURES

- * 400 Volt V_{CE0}
- * 0.5 Amp continuous current
- * Low saturation voltage

COMPLEMENTARY TYPE – FZT658

PARTMARKING DETAIL – FZT758



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Collector-Base Voltage | V_{CBO} | -400 | V |
| Collector-Emitter Voltage | V_{CEO} | -400 | V |
| Emitter-Base Voltage | V_{EBO} | -5 | V |
| Peak Pulse Current | I_{CM} | -1 | A |
| Continuous Collector Current | I_C | -500 | mA |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | P_{tot} | 2 | W |
| Operating and Storage Temperature Range | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +150 | $^{\circ}C$ |

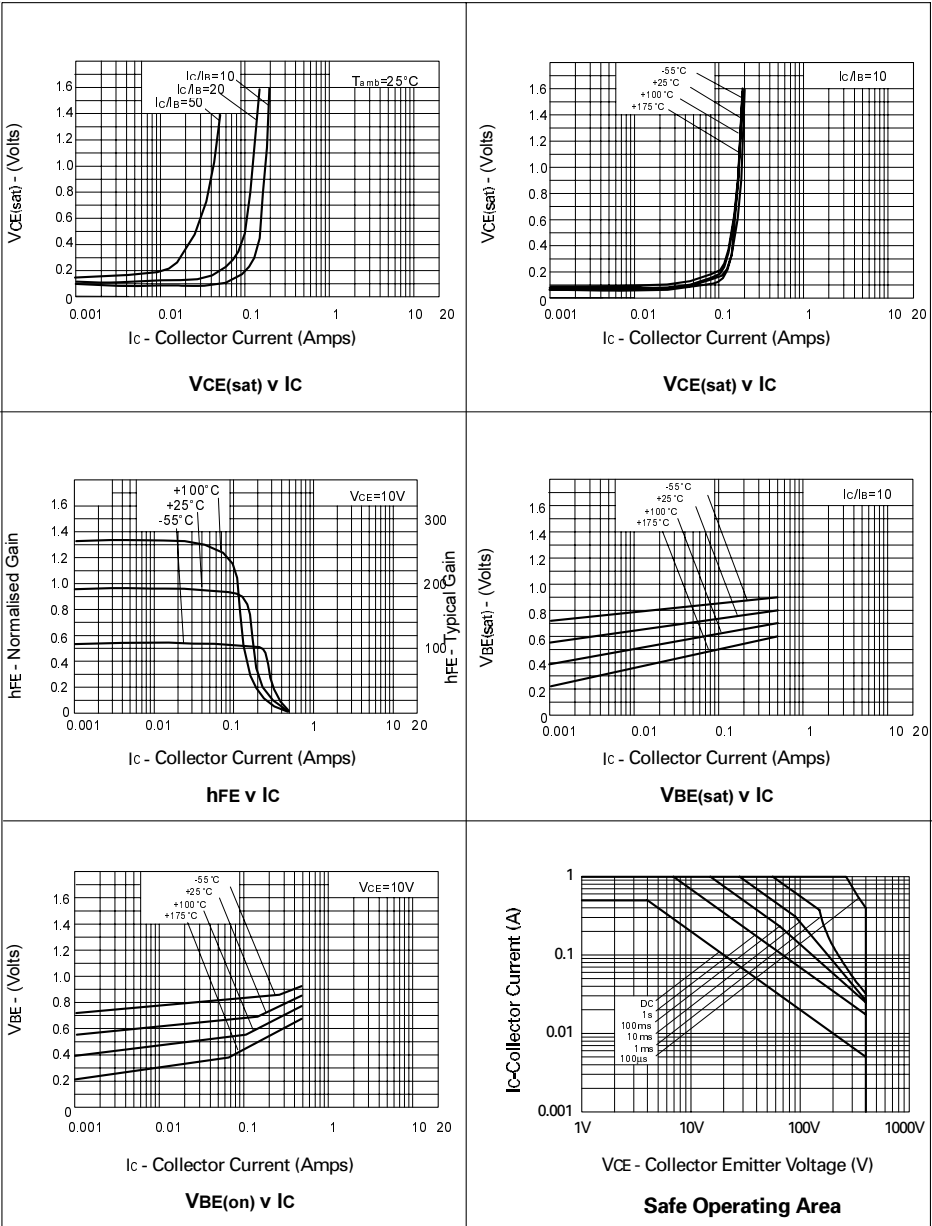
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|---|
| Collector-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)CBO}$ | -400 | | V | $I_C = -100\mu A$ |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | $V_{CEO(SUS)}$ | -400 | | V | $I_C = -10mA^*$ |
| Emitter-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)EBO}$ | -5 | | V | $I_E = -100\mu A$ |
| Collector Cut-Off Current | I_{CBO} | | -100 | nA | $V_{CB} = -320V$ |
| Collector Cut-Off Current | I_{CES} | | -100 | nA | $V_{CE} = -320V$ |
| Emitter Cut-Off Current | I_{EBO} | | -100 | nA | $V_{EB} = -4V$ |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | | -0.30 -0.25 -0.50 | V V V | $I_C = -20mA, I_B = -1mA$ $I_C = -50mA, I_B = -5mA^*$ $I_C = -100mA, I_B = -10mA^*$ |
| Base-Emitter Saturation Voltage | $V_{BE(sat)}$ | | -0.9 | V | $I_C = -100mA, I_B = -10mA^*$ |
| Base-Emitter Turn On Voltage | $V_{BE(on)}$ | | -1.0 | V | $I_C = -100mA, V_{CE} = -5V^*$ |
| Static Forward Current Transfer Ratio | h_{FE} | 50 50 40 | | | $I_C = -1mA, V_{CE} = -5V$ $I_C = -100mA, V_{CE} = -5V^*$ $I_C = -200mA, V_{CE} = -10V^*$ |
| Transition Frequency | f_T | 50 | | MHz | $I_C = -20mA, V_{CE} = -20V$ $f = 20MHz$ |
| Output Capacitance | C_{obo} | | 20 | pF | $V_{CB} = -20V, f = 1MHz$ |
| Switching times | t_{on} t_{off} | 140 2000 | Typical Typical | ns ns | $I_C = -100mA, V_{CC} = -100V$ $I_{B1} = 10mA, I_{B2} = -20mA$ |

* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for this device

TYPICAL CHARACTERISTICS





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331